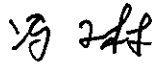


附件 2:

单一来源采购专家论证意见表

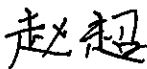
时间: 2024 年 08 月 28 日

主管单位	教育部
使用单位	北京大学
项目名称	高温真空烤盘炉
项目金额(元)	71 万元
专家论证意见	<p>申请人主要从事氮化物半导体材料及器件方面的研究。在氮化物半导体的 MOCVD 外延过程中, 石墨盘载具表面会沉积氮化物, 必须通过高温处理清洁其表面, 以确保石墨盘在后续外延过程中保持最佳状态。申请人使用的石墨盘载具尺寸为 300 mm, 高温处理温度需不低于 1400°C。申请人拟采购高温真空烤盘炉设备, 考虑到研究需求, 只有文生真空科技股份有限公司的 HBM-465G 型号设备能满足申请人对该设备最高工作温度、工作区域尺寸和设备尺寸的要求。因此, 本套设备必须以单一来源的方式采购。</p> <p>专家姓名: 冯玉林 </p> <p>职 称: 副教授</p> <p>工作单位: 北京信息科技大学</p>

附件 2:

单一来源采购专家论证意见表

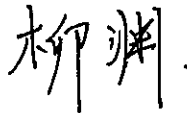
时间: 2024 年 08 月 28 日

主管单位	教育部
使用单位	北京大学
项目名称	高温真空烤盘炉
项目金额(元)	71 万元
专家论证意见	<p>申请人拟采购高温真空烤盘炉, 用于高温烘烤 MOCVD 外延使用的石墨盘, 以除去石墨盘表面的氮化镓和氮化铝沉积物。经调研, 满足申请人对设备最高工作温度、温度均匀性、真空度、升降温速率、工作区域尺寸和设备尺寸要求的只有中国台湾文生真空科技股份有限公司生产的 HBM-465G 型高温真空烤盘炉设备。鉴于上述原因, 本套设备必须以单一来源的方式采购。</p> <p>专家姓名: 赵超 </p> <p>职 称: 研究员</p> <p>工作单位: 中科院半导体所</p>

附件 2:

单一来源采购专家论证意见表

时间: 2024 年 08 月 28 日

主管单位	教育部
使用单位	北京大学
项目名称	高温真空烤盘炉
项目金额(元)	71 万元
专家论证意见	<p>申请人计划采购一台高温真空烤盘炉,用于高温处理去除 MOCVD 外延所用的石墨盘表面沉积物。待处理的石墨盘载具直径不超过 300 毫米,主要沉积物为氮化铝和氮化镓。因此,要求所采购的高温真空烤盘炉具备相应的处理能力,且其工作区域直径应大于并接近石墨盘的直径。此外,考虑到实验室场地和设备进场通道的限制,设备的最大模块尺寸不得超过 1.6 米。经过申请人详细调研,发现只有文生真空科技股份有限公司能够提供满足以上要求的设备型号。因此,本套设备需以单一来源的方式进行采购。</p> <p>专家姓名: 柳渊 </p> <p>职 称: 教授</p> <p>工作单位: 北京信息科技大学</p>